

# Germanium PNP Transistor


## **GC112**

80V / 150mA

# DATASHEET

OEM – RFT

Source: RFT Datenbuch Germanium Transistoren 71/72



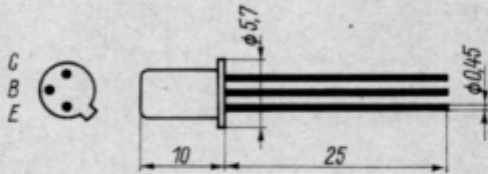
**RFT**  
electronic

## GC 112

---

Germanium-pnp-Transistor der Bauform A 3/25-b nach TGL 11 811 für Steuer- und Regelzwecke mit induktiver Last und hoher Sperrspannung, besonders in Ablenkeinheiten von TV-Empfängern.

---




Masse ca. 0,8 g

---

**Grenzwerte**

Kollektor-Emitter-Spannung		$-U_{CES} = 80 \text{ V}$
$R_{BE} = 0 \Omega$		
Emitter-Basis-Spannung		$-U_{EBO} = 20 \text{ V}$
Kollektorstrom		$-I_{CL} = 150 \text{ mA}$
Basisstrom		$-I_{BL} = 50 \text{ mA}$
Sperrschichttemperatur		$\theta_{JL} = +80 \text{ }^\circ\text{C}$
Umgebungstemperatur		$\theta_{aL} = -25 \text{ }^\circ\text{C bis } +65 \text{ }^\circ\text{C}$
Wärmewiderstand		$R_{thja} \leq 380 \text{ grd/W}$
Wärmewiderstand		$R_{thjc} \leq 50 \text{ grd/W}$

---




**KOMBINAT VEB HALBLEITERWERK FRANKFURT (ODER)**  
Stambetrieb Halbleiterwerk Frankfurt (Oder)

8.69

25

GC 112



---

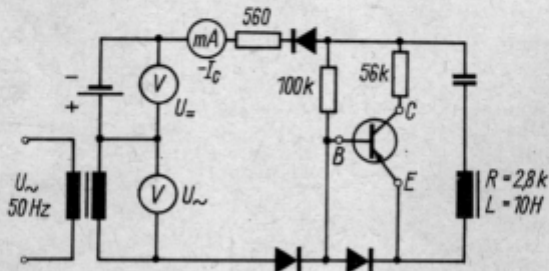
Statische Kennwerte		Min.	Typ	Max.
Kollektor-Basis-Reststrom $-U_{CB} = 15\text{ V}$	$-I_{CBO}$		9 $\mu\text{A}$	18 $\mu\text{A}$
Kollektor-Emitter-Reststrom $-U_{CES} = 80\text{ V}$ $R_{BE} = 0\ \Omega$	$-I_{CES}$		300 $\mu\text{A}$	500 $\mu\text{A}$
Emitter-Basis-Reststrom $-U_{EB} = 10\text{ V}$	$-I_{EBO}$			50 $\mu\text{A}$

Dynamische Kennwerte		Min.	Typ	Max.
Übergangsfrequenz $-U_{CE} = 6\text{ V}$ $-I_C = 2\text{ mA}$	$f_T$	300 kHz		
Kurzschlußstromverstärkung $-U_{CE} = 6\text{ V}$ $-I_C = 2\text{ mA}$	$h_{21E}$	10		80

Spezialmessung:  
Kollektorstrom nach angegebener Schaltung:  
 $-I_C = 10\text{ mA}$

$-U_{CE} = U = + U_{\sim}$   
 $U = (66\text{ V} \pm 2)\text{ V}$   
 $U_{\sim} = (90\text{ V} + 5)\text{ V}_{\text{eff}}$



Bestellbeispiel für einen Transistor

Transistor GC 112

---

8.69  
26

KOMBINAT VEB HALBLEITERWERK FRANKFURT (ODER)

Stambetrieb Halbleiterwerk Frankfurt (Oder)

